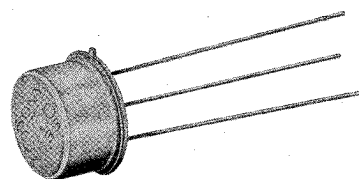


ソニートランジスタ 2SC756 は、新らしく開発された、APM型シリコントランジスタ (Advanced Passivated Mesa Transistor) で、接合部を不活性化し、かつ、その表面に対し独特の安定化処理を行なった高性能、高信頼性のトランジスタです。

2SC756 は、優れた電圧特性、電流特性を持ち、高周波電力増幅、低周波電力増幅、高中速度スイッチング等に広く御使用いただけます。



絶 対 最 大 定 格		C 756-2	C 756-3	C 756-4	Ta=25°C
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	100	130	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	60	80	100	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}		6		V
コレクタ電流	I _C		4		A
ベース電流	I _B		0.8		A
コレクタ損失	P _C		10 (T _c =25°C)		W
ジャンクション温度	T _j		175		°C
保存温度	T _{stg}		-65~+200		°C

電 気 的 特 性			Ta=25°C			
項 目	記 号	条 件	最小値	標準値	最大値	単 位
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	I _C =100 mA	C 756-2	60		V
			C 756-3	80		
			C 756-4	100		
コレクタ遮断電流	I _{CBO}	V _{CB} =50 V			3	μA
コレクタ・エミッタ遮断電流	I _{CEO}	V _{CE} =60V	C 756-2		5	mA
		V _{CE} =80V	C 756-3			
		V _{CE} =100V	C 756-4			
エミッタ遮断電流	I _{EBO}	V _{EB} =5 V			100	μA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(SAT)}	I _C =2A, I _B =0.4A		0.4	0.8	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V _{BE(SAT)}			1.1	1.6	V
直流電流増幅率	h _{FE1}	I _C =10 mA, V _{CE} =2 V		50		
直流電流増幅率	h _{FE3}	I _C =100 mA, V _{CE} =2 V	30	80	173	
ベース・エミッタ電圧	V _{BE}			0.7	0.8	V
直流電流増幅率	h _{FE5}	I _C =1 A, V _{CE} =2 V		70		
ベース・エミッタ電圧	V _{BE}			0.8	1	V
遮断周波数	f _T	I _E =-50 mA, V _{CE} =10 V	35	65		MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1MHz		35	60	PF
C _c ・r _{bb'}	C _c ・r _{bb'}	V _{CE} =10V, I _E =-50mA, f=1.59MHz		50	150	PS